

中国科学院半导体研究所
拟投资丽水中科先进半导体研究中心有限公司
情况公示

半导体研究所拟以科技成果作价入股的形式,投资丽水中科先进半导体研究中心有限公司(暂定名,最终以登记成立的名称为准,以下简称丽水半导体公司),现根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《中国科学院半导体研究所对外投资管理办法》等规定,将相关情况予以公示。

一、投资用资产及评估情况

序号	内容或名称	专利号	类型	申请日期	取得日期
1	降低基区电阻率的 GaN 基 HBT 外延结构及生长方法	ZL 2015 1 0309494.6	发明专利	2015.06	2019.05
2	一种具有极化诱导掺杂高电阻层的 GaN 基 HEMT 结构及生长方法	ZL 2014 1 0505205.5	发明专利	2014.09	2018.10

经第三方评估(评估报告:北方亚事评报字[2019]第 01-611 号),上述 2 项发明专利评估价值为人民币 490 万元。

二、投资用资产作价及股权比例情况

丽水半导体公司全体出资人经协商,同意半导体研究所以上述 2 项发明专利作价人民币 490 万元,投资丽水半导体公司。投资完成后,半导体研究所出资金额为 200 万元,占有公司 20%股权,GaN 器件与集成应用(张韵)研发团队出资金额为 290 万元,占有公司 29%股权。

三、公示期间:2019 年 11 月 13 日至 2019 年 12 月 3 日

在公示期间内,如对以上出资行为、资产作价及股权比例情况存有异议,请以书面方式实名向半导体研究所投资资产管理委员会反映。

联系电话:010-82304042(投资资产管理委员会办公室)

联系人:石砥

2019 年 11 月 13 日